

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Факультет Електроніки
Кафедра мікроелектроніки

ЗВІТ

Про виконання практичної роботи №2
з дисципліни: «Твердотільна електроніка-2»

Діодне включення біполярного інтегрального
транзистора в напівпровідникових ІМС.

Виконавець:
Студент 3-го курсу

(підпис)

Б. В. Лищенко

Перевірив:

(підпис)

О. В. Мачулянський

ЗАВДАННЯ

1. еквівалентні схеми інтегральних діодів в біполярних ІМС;
2. та переріз структур для наступних варіантів діодного включення ІТ:
 - (а) перехід Б-Е з колектором, закороченим на базу;
 - (б) паралельне включення обох переходів.

1

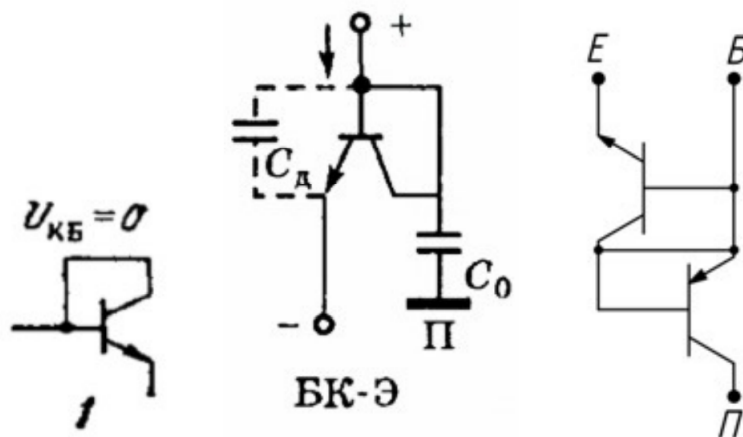


Рис. 1: перехід Б-Е з колектором, закороченим на базу.

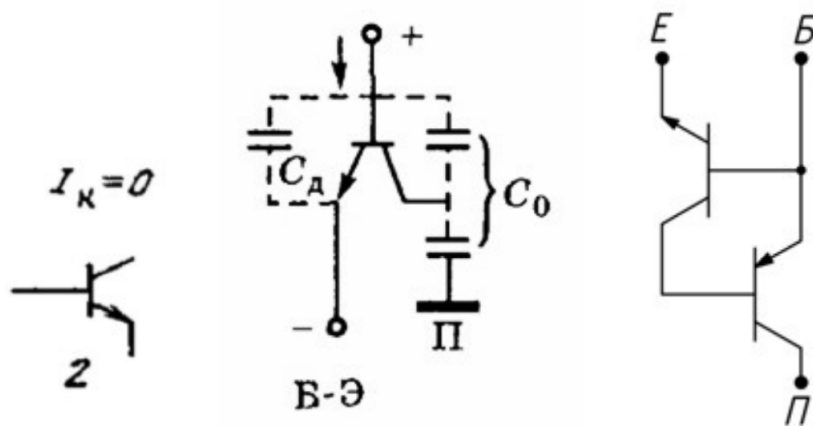


Рис. 2: перехід Б-Е з розімкнутим ланцюгом колектора.

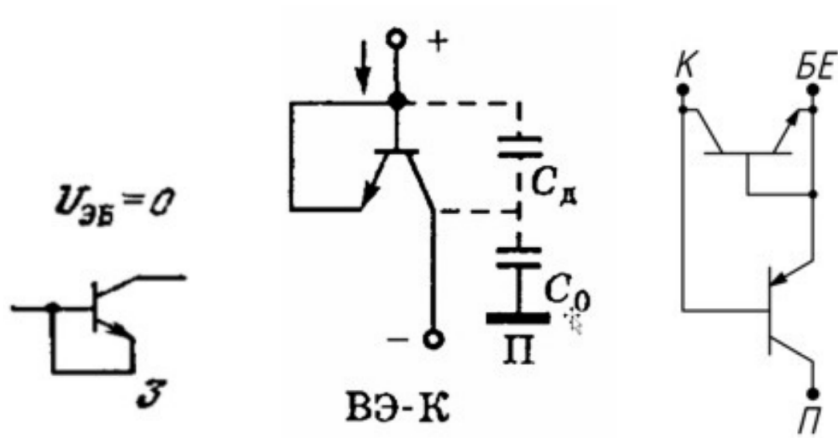


Рис. 3: перехід К-Б з емітером, закороченим на базу.

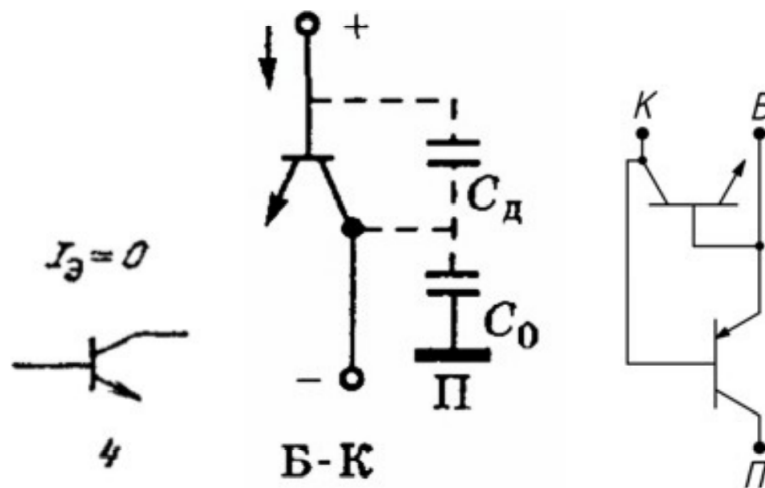


Рис. 4: перехід Б-К з розімкнутим ланцюгом емітера.

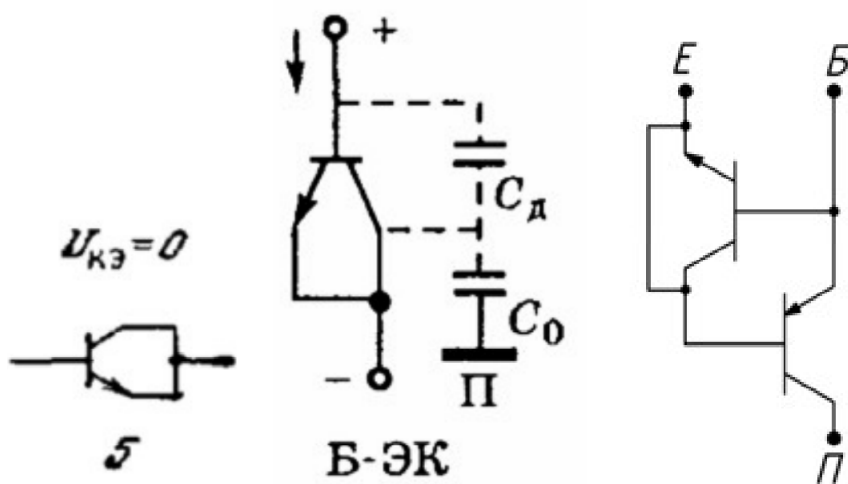


Рис. 5: паралельне включення обох переходів.

